

**CONFÉDÉRATION SUISSE**  
OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: H 01 J      37/32  
H 05 H      1/42



**Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein**  
Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

**⑫ FASCICULE DU BREVET A5**

(11)

**620 314**

⑯ Numéro de la demande: 2642/77

⑬ Titulaire(s):  
International Plasma Corporation, Hayward/CA  
(US)

⑭ Date de dépôt: 02.03.1977

⑭ Inventeur(s):  
James Francis Battey, Los Altos/CA (US)  
Richard Lewis Bersin, San Lorenzo/CA (US)  
Richard Francis Reichelderfer, Castro Valley/CA  
(US)  
Joseph Milton Welty, Fremont/CA (US)

⑮ Brevet délivré le: 14.11.1980

⑯ Fascicule du brevet  
publié le: 14.11.1980

⑰ Mandataire:  
A. Braun, Basel

**⑭ Procédé et appareil de traitement chimique dans une décharge luminescente.**

⑮ On introduit un réactif gazeux dans une chambre à réaction comportant deux électrodes, en présence d'une matière à traiter, on alimente les électrodes pour ioniser le gaz et l'on crée une impédance entre les électrodes, de telle sorte que le courant ionisant et le plasma formé soient répartis de façon uniforme à travers toute la région comprise entre les électrodes. Outre la chambre à électrodes, l'appareil comprend un dispositif d'introduction du réactif gazeux, un dispositif d'alimentation des électrodes et un dispositif de support pour la matière à traiter. Le procédé et l'appareil peuvent être appliqués, par exemple, à l'attache chimique de l'aluminium.

## REVENDICATIONS

1. Procédé de traitement chimique d'une matière dans un plasma formé par ionisation d'un réactif gazeux dans une chambre réactionnelle comportant deux électrodes parallèles sous alimentation électrique, entre lesquelles est disposée la matière à traiter, caractérisé en ce qu'il comprend le maintien entre les électrodes d'un espace assez faible pour que l'impédance au courant ionisant directement entre les parties centrales des électrodes soit sensiblement inférieure à l'impédance d'un trajet allant des parties centrales vers l'extérieur le long des électrodes et le long de la paroi de la chambre entre les bords des électrodes, la création d'une impédance supérieure à l'impédance du plasma entre les électrodes afin de répartir le courant ionisant et l'ionisation du gaz à travers toute la région située entre les électrodes et la disposition de la matière en contact direct avec le gaz ionisé dans la région de ionisation.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'impédance répartie est formé par disposition d'une matière diélectrique entre les électrodes.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les électrodes sont connectées à l'alimentation et déconnectées de celle-ci de façon cyclique.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'introduction d'un gaz dans la région comprise entre les électrodes, lorsque celles-ci ne sont pas alimentées.

5. Appareil destiné à la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif délimitant une chambre réactionnelle, un dispositif d'introduction d'un réactif gazeux dans la chambre, deux électrodes parallèles, un dispositif d'alimentation des électrodes afin que le gaz s'ionise et forme un plasma contenant au moins une espèce chimiquement active dans la chambre, l'espace entre les électrodes étant assez faible pour que l'impédance au courant ionisant directement entre les parties centrales des électrodes soit sensiblement inférieure à l'impédance d'un trajet allant des parties centrales vers l'extérieur le long des électrodes et le long de la paroi de la chambre entre les bords des électrodes, une matière diélectrique ayant une impédance supérieure à celle du plasma placé entre les électrodes pour assurer la répartition du courant d'ionisation et l'ionisation des électrodes, et un dispositif de support pour la matière à traiter directement dans la région d'ionisation, la surface principale de la matière étant parallèle aux électrodes.

6. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce que la matière diélectrique est du quartz ou du verre.

7. Appareil selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que la matière diélectrique est un corps plan ayant des orifices perpendiculaires aux électrodes, la matière à traiter étant alignée sur l'un des orifices.

---

La présente invention concerne un procédé et un appareil de réaction chimique dans la région de décharge luminescente d'un plasma.

Dans les réacteurs à plasma du type que concerne l'invention, le réactif gazeux est excité par de l'énergie à haute fréquence, dans une chambre réactionnelle. Ces réacteurs sont utiles dans des applications très diverses, notamment pour l'attaque chimique de divers métaux tels que l'aluminium.

On note que, dans les réacteurs à plasma de type connu, le courant d'ionisation a tendance à se concentrer vers les parois de la chambre, à la manière de l'effet électrique de peau, ou de la tendance des courants à haute fréquence à se propager près de la surface des conducteurs métalliques. Dans un réacteur à plasma, l'espèce ionisée et excitée qui forme le plasma est essentiellement formée dans la région de passage du courant.

Dans cette même région, la lumière visible provenant de la décharge luminescente est créée par disparition de diverses espèces à des états électroniquement excités. La durée de certaines espèces excitées électroniquement est apparemment si faible que ces espèces n'ont pas le temps de diffuser hors de la région de concentration du courant. On constate qu'on ne peut utiliser certaines réactions, par exemple l'attaque chimique de l'aluminium, que dans la région de décharge luminescente, et, lorsque cette décharge n'a lieu que près des parois du réacteur, seule une petite partie de la chambre peut être utilisée.

Dans le procédé et l'appareil selon l'invention, le courant d'ionisation est pratiquement uniforme dans toute la région comprise entre les électrodes et les réactions peuvent être mises en œuvre à un emplacement quelconque de cette région. La répartition du courant est uniforme car la distance séparant les électrodes est faible et une impédance répartie est montée en série avec le plasma afin que l'impédance mesurée au centre du plasma soit pratiquement la même que dans la partie externe.

Dans un mode de réalisation avantageux, les électrodes sont planes et l'impédance répartie est formée par une feuille d'une matière diélectrique adjacente à l'une des électrodes.

L'invention concerne donc un procédé et un appareil de réaction chimique dans un plasma formé par un gaz.

Elle concerne aussi un procédé et un appareil du type décrit dans lesquels le courant d'ionisation et la décharge luminescente du plasma sont répartis dans toute la région comprise entre les électrodes.

Ce procédé et cet appareil conviennent particulièrement bien à l'attaque chimique de l'aluminium.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description qui va suivre, faite en référence au dessin annexé sur lequel:

- la figure 1 est un schéma d'un mode de réalisation de l'appareil. Ce mode de réalisation convient particulièrement bien à l'attaque de l'aluminium;
- la figure 2 est un schéma d'un autre mode de réalisation d'appareil de traitement de plaquettes selon l'invention; et
- la figure 3 est une coupe partielle agrandie d'une plaque d'un type qui peut être traité dans l'appareil de la figure 2.

L'appareil représenté sur la figure 1 comprend deux électrodes sensiblement planes et distantes 11 et 12. Les électrodes sont formées d'une matière conductrice de l'électricité et elles sont maintenues parallèlement l'une à l'autre. Dans ce mode de réalisation, les électrodes forment les parois supérieure et inférieure d'une chambre 13 qui a aussi une paroi latérale cylindrique 14 en matière isolante convenable, par exemple en quartz. L'électrode 11 est montée de manière amovible à la partie supérieure de la paroi latérale 14 et permet l'accès à la chambre.

Un dispositif permet la circulation d'un réactif gazeux dans la chambre 13. Il comprend une entrée 16 de gaz ayant une soupape 17 de réglage de débit et une pompe 18 à vide reliée à une sortie 19. Dans le mode de réalisation représenté, l'entrée et la sortie sont montées sur une paroi latérale 14 aux extrémités opposées de la chambre, mais il faut noter qu'elles peuvent être disposées à tout emplacement convenable de la chambre, par exemple sur l'électrode 11. Les gaz réactifs convenant à l'attaque chimique de matières telles que l'aluminium sont le chlore et les hydrocarbures contenant du chlore, et on obtient des résultats particulièrement bons avec le tétrachlorure de carbone  $\text{CCl}_4$ . Lors de l'attaque de composés du silicium et d'autres matières, les gaz qui conviennent sont notamment  $\text{CF}_4$ ,  $\text{CHF}_3$  et d'autres composés contenant du fluor.

Le débit du réactif gazeux est réglé afin que le gaz reste dans la chambre pendant un temps optimal afin que la création et la disparition de l'espèce active qui assure l'attaque chimique soient équilibrées, mais ce temps ne doit pas être tel que les

sous-produits de la réaction inhibent sérieusement celle-ci. Dans le cas où l'on applique le procédé à  $\text{CCl}_4$ , par exemple on constate qu'un temps de séjour de l'ordre de  $1/_{25}$  s donne des résultats particulièrement avantageux. Dans le mode de réalisation avantageux,  $\text{CCl}_4$  pénètre dans une chambre de  $300 \text{ cm}^3$  avec un débit de l'ordre de  $40$  à  $70 \text{ cm}^3/\text{min}$ , à la pression atmosphérique, et une pompe 18 retire le gaz de la chambre avec un débit de l'ordre de  $7500 \text{ cm}^3/\text{s}$ , si bien que le temps de séjour est égal à  $300/7500 = 1/_{25}$  s, la pression dans la chambre étant de l'ordre de  $0,1 \text{ torr}$ . On constate que les pressions comprises entre  $0,05$  et  $0,5 \text{ torr}$  donnent des résultats satisfaisants.

Un dispositif est destiné à l'alimentation des électrodes 11 et 12 afin que celles-ci créent un champ électrique d'ionisation du gaz présent dans la chambre 13. Le dispositif utilisé comprend un générateur 21 à haute fréquence relié aux électrodes 11 et 12 par des fils 22 et 23. Dans un mode de réalisation avantageux, le générateur fonctionne à une fréquence de l'ordre de  $13,56 \text{ MHz}$  et à une puissance de l'ordre de  $50 \text{ W}$ , bien que d'autres fréquences et d'autres puissances puissent être utilisées le cas échéant.

Comme indiqué précédemment, l'espacement des électrodes est faible et une impédance répartie est placée en série avec le plasma afin que la répartition du courant et l'ionisation du plasma soient pratiquement uniformes dans toute la région comprise entre les électrodes. Comme l'impédance répartie est relativement grande par rapport à l'impédance du plasma, le courant passant au centre du plasma est rendu pratiquement égal à celui qui passe dans la partie externe du plasma. Lorsque l'impédance d'un trajet passant par le centre du plasma est faible par rapport à celle d'un trajet allant du centre à la paroi externe de la chambre, la répartition du courant dans le plasma est aussi pratiquement uniforme.

Lorsque les électrodes sont circulaires et ont un diamètre de  $203,2 \text{ mm}$  (par exemple, lorsque elles sont utilisées pour l'attaque de l'aluminium) et lorsqu'elles reçoivent une puissance de  $50 \text{ W}$ , on peut obtenir des résultats satisfaisants avec un espace-  
ment d'électrodes de  $2,54 \text{ mm}$  ou moins, une valeur de  $10,2 \text{ mm}$  donnant des résultats particulièrement satisfaisants. En général, la distance comprise entre les électrodes doit être nettement inférieure au diamètre de celles-ci, et le rapport du diamètre des électrodes à leur espace-  
ment est avantageusement d'au moins  $3/1$ .

Dans le mode de réalisation de la figure 1, une plaque 26 de matière diélectrique est disposée sur l'électrode 12 et constitue une impédance répartie. Des matières diélectriques qui conviennent sont le quartz, le verre «Pyrex» et d'autres verres et on obtient des résultats satisfaisants avec une plaque de verre «Pyrex» ayant une épaisseur de l'ordre de  $1,6 \text{ mm}$ . La présence de la matière diélectrique assure non seulement la répartition du courant d'ionisation dans le plasma, mais aussi le passage d'une partie du courant d'ionisation dans une plaquette ou une autre pièce disposée dans le plasma.

Dans le mode de réalisation représenté, une plaquette semi-conductrice 27 repose sur la plaque de matière diélectrique. Cependant, les positions relatives de la matière diélectrique et de la plaquette ne sont pas particulièrement délicates dans la mesure où leur disposition est en série entre les électrodes. Ainsi, la matière diélectrique peut être placée par exemple près de l'électrode supérieure et la plaquette peut être placée directement sur l'électrode inférieure.

A titre illustratif, on a représenté une plaquette 27 qui comprend un substrat 28 d'une matière semi-conductrice dans laquelle des régions d'impuretés convenables sont formées selon un procédé bien connu pour la formation des dispositifs à semi-conducteur. Une couche 29 de silice  $\text{SiO}_2$  recouvre le substrat et est elle-même recouverte d'une couche d'aluminium 31. Une

couche de réserve photographique 32 est formée sur l'aluminium et des fenêtres 33 sont formées dans la couche de réserve afin que les régions de l'aluminium qui doivent être retirées soient exposées.

5 Dans une autre application possible, un dispositif est aussi utilisé pour l'admission d'un gaz oxydant tel que l'oxygène ou l'air, ou d'un gaz réducteur tel que l'hydrogène dans la chambre 13 lors du cycle d'attaque d'aluminium. Ce dispositif comprend une entrée 38 de gaz ayant une soupape 39 de réglage de débit 10 montée sur la paroi latérale 14. L'introduction du gaz oxydant permet la formation de composés de l'aluminium contenant de l'oxygène sur les surfaces exposées de l'aluminium, ces composés facilitant la lutte contre l'affouillement de l'aluminium. L'addition d'un gaz contenant de l'hydrogène permet la formation d'hydrures d'aluminium sur les faces exposées de l'aluminium et ces composés de l'aluminium facilitent aussi la lutte contre l'affouillement. On constate que l'air convient particulièrement bien à cet effet car il contient à la fois de l'oxygène et de l'hydrogène.

15 20 Un dispositif convenable de chauffage (non représenté) est destiné à maintenir les électrodes à une température pré-déterminée. Ce dispositif peut comprendre tout appareil convenable de chauffage. Dans l'application à l'attaque chimique d'aluminium par exemple, les électrodes 11, 12 sont maintenues à des températures de l'ordre de  $75$  à  $125^\circ \text{C}$  et  $75$  à  $135^\circ \text{C}$  respectivement.

25 Dans l'application à l'attaque d'aluminium, celui-ci peut former une couche 31 sur une plaquette semi-conductrice 27. On suppose que la plaquette 27 et l'organe diélectrique 26 ont été placés dans la chambre 13 comme représenté et que les électrodes 11 et 12 sont à une température comprise entre  $75$  et  $125^\circ \text{C}$  pour l'une et  $75$  à  $135^\circ \text{C}$  pour l'autre respectivement. Les soupapes 17 et 39 sont fermées et la pompe 18 fonctionne afin qu'elle réduise la pression dans la chambre à une faible 30 valeur nettement inférieure à  $0,1 \text{ torr}$ . La soupape 17 est alors ouverte et transmet le réactif gazeux dans la chambre avec un débit convenable tel que  $49$  à  $70 \text{ cm}^3/\text{min}$ , si bien que la pression dans la chambre atteint la valeur de travail de l'ordre de  $0,1 \text{ torr}$ . Les électrodes sont alors alimentées afin que le gaz 35 soit ionisé et forme un plasma qui assure l'attaque chimique. Comme indiqué précédemment, la décharge luminescente se répartit uniformément entre les électrodes et la plaquette peut être disposée à un emplacement quelconque dans cette région.

40 45 On constate que le procédé d'attaque chimique peut être amélioré par utilisation cyclique. Dans cette application, on peut introduire en autre un gaz oxydant, l'oxygène ayant une concentration qui croît sur les surfaces exposées d'aluminium, entre les périodes d'attaque. Le nombre et la durée des cycles dépendent de l'épaisseur de l'aluminium à retirer et de la teneur de l'aluminium en autres matières. Cependant, on constate que 3 à 5 périodes d'attaque de  $3$  à  $3,5 \text{ min}$  chacune donnent satisfaction dans le cas de la plupart des plaquettes.

50 Lors du procédé cyclique, le courant d'ionisation peut être maintenu pendant une période de l'ordre de  $3$  à  $3,5 \text{ min}$ , et le courant est arrêté et la soupape 17 est fermée afin que le réactif gazeux ne puisse plus pénétrer dans la chambre. La pompe 18 continue à fonctionner jusqu'à ce que la pression dans la chambre revienne au niveau de base inférieur à  $0,08 \text{ torr}$ , et la pompe est alors arrêtée. La soupape 39 est alors ouverte et laisse pénétrer l'air ou un autre gaz oxydant convenable. L'air pénètre avec un débit convenable et pendant un temps convenable afin que le gaz contenant l'oxygène s'accumule sur les surfaces exposées de l'aluminium. Lorsque la chambre a un volume de l'ordre de  $300 \text{ cm}^3$ , on obtient des résultats convenables par admission d'air à raison de  $300 \text{ cm}^3/\text{min}$  pendant un temps de l'ordre de  $45 \text{ s}$ . Après l'admission d'air, on ferme la soupape 39 et la pompe 18 est commandée à nouveau afin 55 60 65

qu'elle réduise la valeur de la pression au niveau de base. La soupape 17 est alors ouverte à nouveau et les électrodes sont alimentées à nouveau pour le cycle suivant.

On considère maintenant un exemple d'application du procédé de l'invention. On utilise les techniques décrites et une couche d'aluminium dont l'épaisseur est de l'ordre de 10 000 Å est retirée d'une plaque semi-conductrice au cours de trois cycles comprenant chacun une période d'attaque de 3,5 min et une période d'oxydation de 45 s. Le volume de la chambre est de 300 cm<sup>3</sup>, et le réactif gazeux est CCl<sub>4</sub> dont le temps de séjour est de l'ordre de 1/2 s. Pendant les périodes d'oxydation, l'air pénètre dans la chambre à raison de 300 cm<sup>3</sup>/min. La pression de travail dans la chambre est de 0,08 torr, et les électrodes supérieure et inférieure sont maintenues à des températures de 75 et 125° C respectivement. Le générateur 21 fonctionne à une fréquence de 13,56 MHz, avec une puissance de 50 W, et les électrodes 11 et 12 sont séparées par une distance de 10,2 mm.

L'appareil représenté sur la figure 2 comprend une chambre 51 ayant des parois 52 en une matière convenable, par exemple en aluminium. Un couvercle amovible non représenté permet la disposition de plaquettes dans la chambre et leur retrait. En général, les électrodes parallèles et planes 53 et 54 sont montées dans la chambre et reliées à une source 56 d'énergie à haute fréquence placée à l'extérieur de la chambre. Une plaque 50 de verre isolant est placée entre l'électrode 53 et la paroi supérieure 52, et des plaques supplémentaires de verre 55 sont disposées le long des bords de la plaque 50 et de l'électrode 53. L'électrode 54 est avantageusement munie de passages permettant la circulation d'eau ou d'un autre fluide convenable de refroidissement maintenant l'électrode à une température relativement faible.

Une entrée 57 est disposée près d'une extrémité de la chambre et permet l'introduction d'un gaz dans celle-ci, et une pompe 58 d'évacuation est reliée à la sortie 59 placée près de l'autre extrémité de la chambre. Avec cette disposition, le gaz pénètre dans la chambre du côté de la première extrémité, circule entre les électrodes et sort par l'autre extrémité. On peut utiliser d'autres circulations de gaz le cas échéant, le gaz pouvant par exemple être introduit par l'électrode inférieure, directement dans la région comprise entre les électrodes.

Un dispositif est destiné à répartir le courant d'ionisation donc l'espèce active du plasma dans la région comprise entre les électrodes. Ce dispositif comprend des plaques de verre 61 et 62 adjacentes à l'électrode supérieure 53. Comme indiqué, la plaque 61 est une plaque pleine de verre dont la face supérieure est adjacente à la face inférieure de l'électrode, et la plaque 62 est une plaque perforée de verre ayant une face supérieure adjacente à la face inférieure de la plaque 61. Les perforations ou orifices 63 traversent verticalement la plaque 62 et concentrent le plasma dans les régions qui se trouvent au-dessous des orifices. La dimension des orifices n'est pas primordiale et on obtient des résultats satisfaisants avec des orifices dont le diamètre est de l'ordre de la moitié du diamètre des plaquettes. Dans un mode de réalisation avantageux convenant à l'attaque chimique de plaquettes de 76 mm, les plaques sont rectangulaires et ont une longueur d'environ 61 cm et une largeur d'environ 30,5 cm, l'épaisseur de la plaque 61 étant d'environ 3,2 mm, celle de la plaque 62 d'environ 9,5 mm, les orifices ayant un diamètre de l'ordre de 38 mm. Les plaquettes 64 reposent à la face supérieure de l'électrode 64 dans l'alignement des orifices, et la distance séparant la face inférieure de l'électrode 53 de la face supérieure de l'électrode 54 est de l'ordre de 25,4 mm.

La figure 3 représente un exemple de structure de plaque 64, comprenant un substrat 66 de matière semi-conductrice telle que le silicium, dont des régions contiennent une impureté

convenable, après formation de manière classique. Une couche 67 de matière isolante telle que SiO<sub>2</sub> recouvre le substrat et une couche 68 d'aluminium est formée sur la silice. L'aluminium passe par les fenêtres 69 de la couche de silice et forme des contacts avec le substrat de silicium, et un cache 71 de réserve photographique est formé sur l'aluminium et délimite un dessin de connexions à former par attaque des parties exposées de l'aluminium.

Des réactifs gazeux convenant à l'attaque de l'aluminium dans l'application de l'appareil de la figure 2 sont le chlore et les hydrocarbures contenant du chlore tels que CCl<sub>4</sub>. Dans le cas de plaquettes du type représenté sur la figure 3, dans lequel des parties de l'aluminium sont directement au contact du silicium, on constate qu'on peut obtenir de meilleurs résultats soit par disposition d'une plaque de quartz sous les plaquettes, sur l'électrode 54, soit par utilisation d'un réactif gazeux qui contient de l'hélium ou un autre gaz inert conducteur de la chaleur. Les résultats sont particulièrement bons lors de l'utilisation d'un mélange contenant 110 parties de CCl<sub>4</sub> et 40 parties d'hélium, en volume.

On considère maintenant le fonctionnement et l'utilisation de l'appareil de la figure 2 dans l'application à l'attaque d'aluminium, permettant la formation de dessins de connexion sur les plaquettes du type représenté sur la figure 3. Lorsque les plaquettes ont été placées sur l'électrode 54, la chambre est fermée et la pompe 58 fonctionne afin qu'elle réduise la pression dans la chambre à un niveau initial de l'ordre de 0,10 à 0,50 torr. Avant l'attaque chimique, un plasma d'oxygène est formé dans la chambre afin qu'il élimine toute l'eau qui peut être présente. Ce plasma est par exemple maintenu pendant un temps de 30 s. Ensuite, les réactifs gazeux sont admis et le plasma d'attaque est formé. Ce plasma est maintenu pendant un temps qui suffit à l'attaque de l'aluminium, par exemple 5 à 7 min par micron d'aluminium, avec un plasma qui contient un mélange de CCl<sub>4</sub> introduit avec un débit de 110 cm<sup>3</sup>/min et d'hélium introduit avec un débit de 40 cm<sup>3</sup>/min. Dans le cas d'un réacteur ayant les dimensions indiquées précédemment, les électrodes sont par exemple alimentées avec une puissance de 1000 à 1100 W, et l'électrode inférieure 54 est maintenue à une température inférieure à 30° C. La pression dans la chambre, lors de l'attaque, est par exemple de l'ordre de 0,29 torr. Après la fin de l'attaque, un second plasma d'oxygène est formé afin qu'il retire les restes de chlore. Ce plasma est par exemple maintenu pendant une période de l'ordre de 2 min. Ensuite, l'appareil est purgé par un gaz inert sec tel que l'argon, et la chambre est ouverte et permet le retrait des plaquettes attaquées. Avant traitement d'un autre lot de plaquettes, la surface de l'électrode inférieure est avantageusement nettoyée à l'acétone.

Le procédé et l'appareil selon l'invention présentent un certain nombre d'avantages et de caractéristiques importants. Le faible espace entre les électrodes et l'impédance relativement élevée montée en série avec le plasma ont tendance à répartir le courant d'ionisation dans tout le plasma qui est alors très uniforme. Lors de l'attaque d'aluminium, l'utilisation d'un processus cyclique permet une attaque importante sans affouillement, si bien que le retrait de l'aluminium est accéléré et est très propre. La décharge luminescente du plasma remplit pratiquement toute la région délimitée entre les électrodes et la réaction peut être réalisée à un emplacement quelconque de cette région.

Bien qu'on ait décrit l'application du procédé et de l'appareil de l'invention en référence à l'attaque d'aluminium porté par des plaquettes semi-conductrices, il faut noter qu'ils conviennent à toute réaction chimique mise en œuvre dans la région de décharge luminescente d'un plasma.

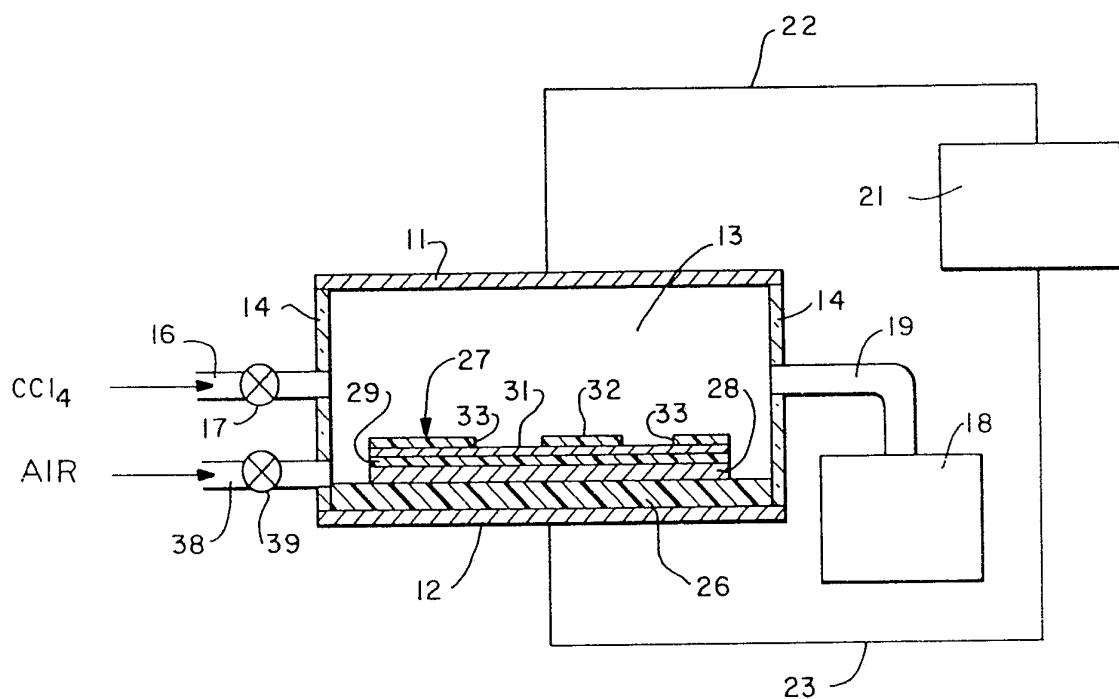


FIG. — 1

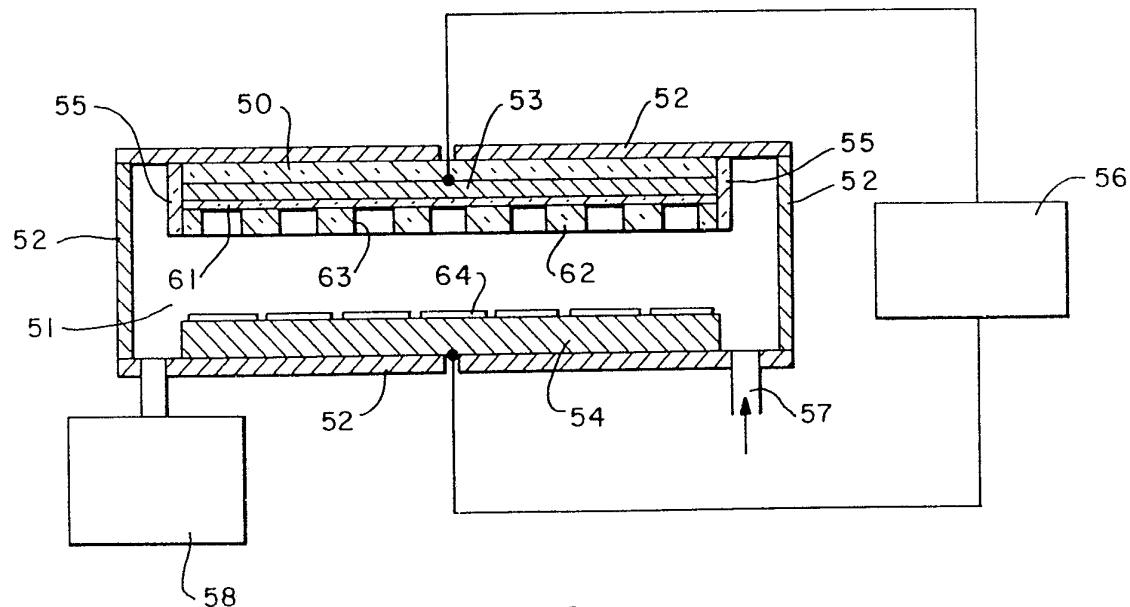


FIG. — 2

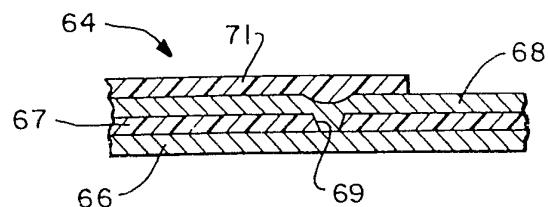


FIG. — 3